PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-015707

(43) Date of publication of application: 19.01.1996

(51)Int.Cl.

G02F 1/1337

G02F 1/13

(21)Application number : **06-148122**

(71)Applicant: STANLEY ELECTRIC CO LTD

KOBAYASHI SHUNSUKE

(22)Date of filing:

29.06.1994

(72)Inventor: HASHIMOTO TORU

KOBAYASHI SHUNSUKE

(3)

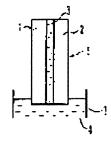
(#)

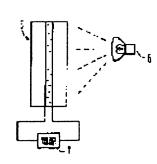
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a liquid crystal display element and the production method thereof by which rubbing treatment is made unnecessary, display defects due to reversed tilt can be suppressed and the amt. of reversed tilt is controlled to improve the display quality by adding a photopolymerizable acrylate resin material having a liquid crystal skeleton to a liquid crystal.

CONSTITUTION: This liquid crystal display element consists of a liquid crystal layer 3 containing a liquid crystal material with addition of a specified amt. of photopolymerizable acrylate resin material having a liquid crystal skeleton, and a pair of substrates 1, 2 which hold the liquid crystal layer 3. A container 4 is filled with the liquid crystal material 3 with addition of the resin, which is injected into the space between the substrates 1, 2. As for the injection method, a method using capillary phenomenon or the like is used. Further, the





liquid crystal cell 5 with the resin-added liquid crystal material 3 injected is irradiated with light from outside to polymerize and harden the photopolymerizable acrylate resin added to the liquid crystal material. When a liquid crystal diacrylate resin is used, the liquid crystal layer is irradiated with light in a UV region. During the irradiatoi of UV rays, specified voltage is applied from a power supply 7 on electrodes of the substrates 1, 2.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.08.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平8-15707

(43)公開日 平成8年(1996)1月19日

(51) Int.CL.6		隸別配号	庁内整理番号	PΙ	技術表示體所
G 0 2 F	1/1337	520			
	1/13	500			

密査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 9 頁)

(21)出願番号	特顧平6-148122	(71) 出顧人 000002303	
		スタンレー電気株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)6月29日	東京都目風区中目風2丁目9	幹13号
		(71)出廢人 591188365	
		小林 酸介	
		東京都緯馬区西大泉 3 - 13 - 4	0
		(72) 発明者 簡本 徹	
		東京都小金共市東町4-8-1	9-210
		(72) 発明者 小林 駿介	
		東京都線局区西大泉 3 -13-4	.0
		(74)代理人 弁理士 高橋 敬四郎 (外	

(54) 【発明の名称】 液晶表示表子とその製造方法

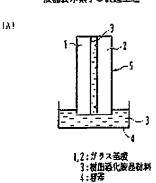
(57)【要約】

【目的】 本発明は、領角依存性をもたらし、表示不良や素子破壊といった製品不良の原因となるラピング処理を不要とするとともに、先の出類の特願平5 - 2 1 0 3 2 0 号と特願平5 - 3 2 6 9 9 0 号で開示されたマルチドメイン構造の液晶セルに発生し得るリバースチルトによる表示欠陥を抑制しまた発生量を制御して表示品位を向上することの可能な液晶表示素子とその製造方法とを提供することを目的とする。

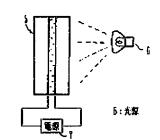
【構成】 本発明による液晶表示装置は、液晶骨骼を持った光重合性アクリレート樹脂材料が所定置だけ添加された液晶材料を含む液晶層と、該液晶層を挟持する一対の基板とを有する。また本発明による液晶表示素子の製造方法は、液晶骨骼を持った光重合性アクリレート樹脂材料が所定置だけ添加された液晶材料を用意する工程と、致液晶材料を所定関隔で対向配置された一対の基板

と、該液晶材料を所定間隔で対向配置された一対の基板 間に注入する工程とを有する。

液晶表示系子の製造工程



(8)



【特許請求の範囲】

【語求項 1 】 液晶骨格を持った光重合性アクリレート 樹脂材料が所定量だけ添加された液晶材料を含む液晶層 と、該液晶層を教持する一対の基板とを有する液晶表示 素子。

1

【請求項2】 前記液晶材料における前記アクリレート 樹脂材料の添加量が実質的に0.1~10.0w 1%の 範囲で選ばれる請求項1記載の液晶表示素子。

【語求項3】 前記液晶特料はカイラルネマチック液晶 あるいはネマチック液晶を含み、前記液晶層の液晶分子 10 の配向方向は前記基板面内方向に関して実質的に巨視的にはほぼあらゆる方向に等確率で分布し、前記基板と垂直な方向に関してほぼ一定のツイスト角を示す語求項 1、2のいずれかに記載の液晶表示素子。

【語求項4】 前記一対の基板の少なくとも一方の上に 形成され、配向方向が異なる多数の微小領域を有する配 向構造を有する語求項1、2のいずれかに記載の液晶表示素子。

【語求項5 】 液晶骨格を持った光重合性アクリレート 樹脂材料が所定量だけ添加された液晶材料を用意するエ 20 程と。

該議晶材料を所定間隔で対向配置された一対の基板間に 注入する工程とを有する液晶表示素子の製造方法。

【語求項6】 前記液晶特料における前記アクリレート 樹脂特料の添加量が実質的に0.1~10.0 w t %の 範囲で選ばれる語求項5記載の液晶表示素子の製造方 法。

【語求項7】 前記液晶材料を注入する工程の後で前記 液晶層に光を照射して該アクリレート樹脂材料を重合せ しめる工程を有する請求項5または6記載の液晶表示素 30 子の製造方法。

【語求項8】 前記光が紫外線領域の光である語求項7 記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項9】 前記光の照射の際に前記基板間に所定の 電圧を印加する請求項7あるいは8記載の液晶表示素子 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は表示品質を改善できる液 晶表示素子とその製造方法とに関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示ディスプレイ等に使用される液晶表示装置いわゆる液晶をルは、液晶の特定な分子配列を電界等の外部からの作用によって別の異なる分子配列に状態変化させて、その間の光学的特性の変化を視覚的な変化として表示に利用している。液晶分子をある特定の配列状態にするために液晶を挟むガラス基板の表面には配向処理を行うのが普通である。

【① ① ① 3】従来のツイストネマチック(TN)形液晶 210320号の明細書には、上記のようなラビングに セルなどでは、配向処理として、液晶を挟むガラス基板 50 伴う問題点を解決するためにラビング処理が不要な液晶

を綿布のようなもので一方向に擦るいわゆるラビング法 が採用されている。

【①①①4】ラビングの方向は上下の墓板間でラビング方向が互いに直交するように行い、液晶セルがネガ表示の場合にはセルを挟む平行ニコル配置の偏光板をその偏光軸がどちらか一方のラビング方向と平行になるように配置し、またボジ表示の場合には、直交ニコル配置の偏光板をその偏光軸が基板のラビング方向と平行になるように配置する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このようなラビングで 配向処理をした場合、液晶分子の配向方向が一様なため に、観測者から画面を見たときの表示が見やすい角度が 特定の角度範囲に制限される視角特性が生じる。

【①①①6】たとえば、従来のツイストネマチック型液晶セル(TN-LCD)の視角特性を表す等コントラスト曲線を測定すると、コントラストの高い視角領域は特定の角度領域に偏っている。したがって、このような液晶セルはある方向からは見えやすく、別の方向からは見えにくいといった視角依存性を持つことになる。

【①①①7】とのような関角依存性をもつ液晶を丸は表示装置として利用した場合には、表示画面に対してある 角度ではコントラストが極端に低下し、甚だしい場合に は表示の明暗が反転してしまう。

【①①①8】液晶セルが視角特性を持つのは、ラビングによって液晶分子にプレチルトが生じるからである。液晶分子がプレチルトを持つ方向は、ラビングするベクトル方向に一致する。

【①①① 9】液晶セルに電圧が印加されると、液晶分子 はプレチルトしている方向に立ち上がってくるために、 その方向が光の電気ベクトルとなる方向から観測した場 台、旋光性が解消されやすくなる。

【0010】 さらに、ラビングする際には、摩擦による 静電気が発生して配向膜に絶縁破壊が起きたり、その部 分の配向不良によって表示不良の原因となる場合があ る。また、アクティブ駆動方式を採用する液晶セルで、 TFT (薄膜トランジスタ)などの駆動素子や配線が表 面に形成された基板をラビングする場合には、ラビング による静電気によって素子や配線が破壊される場合があ 40 る。

【①①11】また、配向膜形成時やラビング時に微小なゴミが大量に発生し、そのゴミが静電気によって基板に付着し、それが液晶セルのギャップ不良や黒点や白点といった表示不良の原因となる場合があることも別の問題点である。

【①①12】本願と同一出願人により平成4年9月4日 付で出願された特顯平4-236652号の明細書ならびに、同出顯を図内優先権主張して出願した特願平5-210320号の明細書には、上記のようなラビングに 伴う問題点を解除するためにラビング処理が不完な液晶

7

3

表示素子とその製造方法について関示されている。

[0013] との特願平5-210320号の明細書に記載の発明の液晶表示素子(以下、a-TN表示素子と称する。)の製造方法においては、基板にラピング等の配向処理は行わない。2枚の透明電極間で液晶分子が90*ツイストしているa-TN表示素子を製作するには、カイラルネマチック液晶のカイラルピッチをpとし、ガラス基板で挟持される方向の液晶層の厚みをdとしたときに、d/p=0.25を満たすようなカイラルピッチpの液晶を使用する。

【①①14】なお、旋光性は90度に限定されない。カイラルネマチック液晶のカイラルピッチをpとし、前記透明基板間の間隔をaとしたときに、0.15<(又は ≒)d/p<(又は≒)0.75となるようにpとdの値を選択すればよいことが開示されている。つまり、セルの所望のツイスト角とセル厚dとによって規定されるカイラルピッチpを持った液晶を用いることにより、ラビング処理が不要な液晶セルを得ることができることが示されている。

【①①15】この先願の発明の方法によれば、液晶分子 25 がある特定の配向方向を持つ微小領域の集合であるマルチドメインが形成され、それらの配向方向はあらゆる方向にランダムに存在する。カイラルネマチック液晶は入射光の偏光軸を全体として所定角度回転させる。この液晶をルに一対の偏向板を用いればボジ表示を実現でき、視角特性が均一な液晶表示装置が得られる。

【①①16】このようなマルチドメイン構造の液晶表示 素子で、完全に等方的な視角特性すなわちあらゆる方向 から視角特性が均一である特性(偏光板自身の特性によ る視角特性の制限を除く)を得るためには、基板上のマ 30 ルチドメインは、各ドメインにおいては液晶分子が一定 方向に揃い、しかもマルチドメイン全体としての液晶分子配列方向はあらゆる方向成分が互いに完全に等確率で 存在しなければならない。

【①①17】本願と同一出願人により平成5年6月29日付で出願された特願平5-159606号の明細書ならびに、同出願を国内優先権主張して出願した特願平5-326990号の明細書には、光偏光記憶膜を基板面に形成し、マルチドメインの個々の微小領域に対応した満極的配向処理を施して各微小領域の一定配向を保証し、しかも同時にマルチドメイン全体としての全方向性の配向も実現する優れた液晶表示素子(以下、SMD-TN表示素子と称する。)が開示されている。

【①①18】これら先の出願の明細書に関示のa - TN 表示素子やSMD-TN表示素子においては、ラビング処理を行わないために液晶分子はプレチルト角を持たない。プレチルトがないと、液晶セルに電圧を印加した場合に、リバースチルトが発生することがあり、その場合は液晶分子の傾きが逆になってしまう界面が線欠陥として現れる。

【①①19】特に、印加電圧がしきい値電圧付近では無数の上記欠陥が発生し、時間の経過または印加電圧の変化につれて欠陥位置が動き回るために、欠陥の存在が目視で認識されやすい。また同時に、光散乱の発生や、コントラストの低下も生じるために液晶表示素子として著しく表示品質を低下させることになる。

【① ① 2 ① 】従来の a - T N表示素子におけるとの表示 欠陥の様子を図5に示す。図5 の(A), (B).

(C) は、液晶セルに10%,50%、90%の透過率 10 を与える管圧であるV₁₀、V₁₀、V₁₀をそれぞれ印加し た時の表示欠陥の変化を撮影した液晶セル表示面の拡大 写真である。ことで、V₁₀は2、1V₁₀は2、7 V₁₀は3、6Vに対応する。

【①①21】写真中、表示欠陥は、細長い白い線状のものとして観察される。Vieの時、最も多く欠陥が発生し、電圧上昇と共に欠陥は減少していく。このような欠陥が発生した場合、液晶セルの光透過率一電圧特性においてヒステリシスが発生してしまい。良好な階調表示ができないという欠点もある。

【0022】本発明の目的は、視角依存性をもたらし、 表示不良や素子破壊といった製品不良の原因となるラビング処理を不要とするとともに、先の出願の特願平5-210320号と特願平5-326990号で開示され たマルチドメイン構造の液晶セルを用いた液晶表示素子 において発生し得る、リバースチルトによる表示欠陥を 抑制し、また発生量を制御して表示品位を向上すること の可能な液晶表示素子とその製造方法とを提供すること にある。

[0023]

【課題を解決するための手段】本発明による液晶表示装置は、液晶骨格を持った光重合性アクリレート樹脂材料が所定置だけ添加された液晶材料を含む液晶層と、該液晶層を挟持する一対の基板とを有する。

【①①24】また本発明による液晶表示素子の製造方法 は、液晶骨格を持った光重合性アクリレート樹脂材料が 所定量だけ添加された液晶材料を用意する工程と、該液 晶材料を所定間隔で対向配置された一対の基板間に注入 する工程とを有する。

[0025]

(作用)液晶骨格を持った光重合性アクリレート樹脂材料を液晶に添加することにより、その液晶材料を使用した液晶表示素子において、リバースチルトに起因する表示欠陥を現れにくくすることができる。印加電圧によって欠陥発生量を制御し、光重合によって欠陥を固定化できる。

[0026]

【実施例】本発明の実施例による液晶表示装置。および その製造方法について、図面を参照して説明する。

【0027】液晶素子の基本機成、および、基本プロセ 50 スは、先願の特願平5-210320号と、特願平5-

326990号に進ずるものである。図2(A)は、本 発明の実施例による液晶表示セルの模式的な断面図であ る。透明ガラス墓板1、2の間に樹脂添加液晶材料3が 挟持されており、その両側に偏光板8、9を備えてい

【① 028】また図2(B), (C)にはそれぞれ、単 純マトリックス駆動方式。およびアクティブマトリック ス駆動方式を用いた液晶表示素子の構造断面を示す。単 純マトリックス駆動方式の場合、一対の基板上に互いに 交差する!TO(インジウムー銀酸化物)等の透明電極 19 却速度でNII点以下まで徐冷する方法を行えばドメイ 群Pを形成する。

【0029】アクティブ駆動方式の場合は、一方の基板 面上にアモルファスa-Si、もしくは、多結晶S!を 用いて構成される溥麒トランジスタ(TFT)駆動素子 Q およびCr、A!等の金属で形成した配線型 透明 画素電極Pさらに絶縁保護膜10が形成される。

【①030】図中カラー表示の際に必要なカラーフィル タ層 ブラックマスクと呼ばれる選光膜は省略してあ る。この液晶表示デバイスの作成には、従来の技術によ べる光偏光記憶膜を用いる場合以外においては、配向膜 は設けない。また本実施例においては、ラビング等によ る通常の配向処理は行わない。従って、通常の液晶表示 装置に備えられる基板全面に共通な単一の配向方向は存 在しない。

【①①31】なお、いずれのデバイス構成の場合も図2 (A)に示した模式的断面構成は共通であり、本発明の 寒龍側においては、液晶母材料として、ネマティク液 品 コレステリック液晶あるいは、ネマテック液晶にカ イラル剤を添加したカイラルネマティク型の液晶を使用 30 m し、この液晶母材料中に液晶骨格を持った光重合性アク リレート樹脂を添加する。添加量は、①、1~10、① wt%の範囲で適宜選択される。

【①032】具体的には、例えば添加物としては骨格部 分に3環の液晶骨格を持ち、その両端にアクリロイル基 を結合した液晶性ジアクリレート樹脂を3 w t %添加し た樹脂添加液晶材料3を用意する。

【りり33】図2(A)における液晶層の厚みdは、先 頭の特願平5-210320号に関示されているよう に、液晶のカイラルピッチをρとしたときに、①≦d/ 40 p ≤ 0. 75なる条件を満たすようにする。好ましく は、0、15<d/p<0、75となる条件を満たすよ うに液晶セルを形成する。この条件において液晶は5.4 度から270度の角度の旋光性を有する。例えば、先顛 の特願平5-210320号では、d/p=0.25 (9)度ツイストに対応)を選択した例を関示してい る。

【①①34】図1(A)は、液晶セル中にジアクリレー ト樹脂を添加した液晶材料を注入するする際の実施例を 模式断面図にて示したものである。容器4には、前記御 50 脂を添加した液晶材料3が入っており、両基板間に液晶 材料3が注入される。注入の方法は、毛細管現象等の方 法を使用する。

【①①35】各基板上に単一方向の配向機造は存在しな いので、液晶層は微小なミクロドメインの集合であるマ ルチドメインを形成する。尚、先願の特願平5-210 320号で関示されるように、液晶注入時に、墓板両側 からヒータのような加熱装置を用いて液晶材料を相転移 温度(N-i)以上に加熱し、注入後0.5℃/分の冷 ンサイズのより揃ったマルチドメイン液晶層を形成でき る。

【①036】さらに樹脂添加液晶材料3が注入された液 晶セル5に、図1(B)に示す方法で、外部より光を照 射して液晶母村斜中の添加した光重合性アクリレート樹 脂を重合、硬化させる。液晶性ジアクリレート樹脂の場 台には紫外線領域の光を照射する。また、この紫外光照 射時に、電源でより基板1.2の電板(図2(B)。

(C)参照)に所定の直流電圧もしくは交流電圧を印加 るプロセスをそのまま利用できる。但し後の実施例で述 20 する。本実施例では交流とした。但し電圧を印加しなく てもよい (電圧) V〉。

> 【①①37】本実施例に従い、紫外線照射時のセル印加 湾圧を、0 V、1 V,1、5 V,2 V、5 V及び 1 0 V の6条件に設定してそれぞれ素子を作成した。図3は、 a-TN表示素子を以上説明した方法を使用して作製し た場合のセル表示面の拡大写真である。図3の写真 (A), (B), (C) はそれぞれ渡晶セルに10%, 50%、90%の透過率を与える電圧であるV₁₆、

Vュ。、 Vュ。を印加したものである。ここでV。。は2. 1 V、Vょ。は2.8V、V。。は3.8Vに相当する。3枚 の写真に移った状態はほとんと変わらず、電圧変化によ って欠陥状態(写真中の白い線状のもの)は変化してい ない。また欠陥が動き回ることもないことがわかる。

【①①38】したがって、欠陥が目視によって認識され ることがなく 発明が解決しようとする課題の欄で説明 した表示品質の低下を防止することができる。さらにヒ ステリシスの発生も防げるために良好な中間階調表示が 得られる。

【①①39】図4は液晶セルへの紫外線照射時にセルに 印加する電圧を変えた場合の表示面の拡大写真である。 図4 (A) の写真では() V. (B) では1 V. (C) で は1.5V, (D)では2V, (E)では5Vの電圧を それぞれ紫外線照射時に印加している。

【()()4()】図4の写真からわかるように、図4(C) で示す1.5 V印加時が最も欠陥置が多くなり、さらに 高い電圧印加では欠陥量は減少している。紫外線照射時 のセル印加電圧を変えることによって、欠陥の発生状態 が変わるので、欠陥の発生量を電圧により制御すること が可能である。

【①①41】光照射時の電圧印加による欠陥の発生状態

の調節と光重合による樹脂の硬化による欠陥の固定化の2つの作用により、欠陥は認識されにくくなる。尚、先願の特願平5-210320号と、特願平5-326990号で開示した光偏向記憶膜を基板面に形成してルチドメインの個々の微小領域に対応した積極的配向処理を施してもよい。このような構成の素子においても液晶骨格を有する光重合性アクリレート樹脂の添加は、同様の効果を提供することができる。

【① ① 4 2 】以下に、光偏光記憶膜を用いた該積極的配 向処理を行った場合の実施例について説明する。

【0043】光偏光記憶膜としては、(1)ジアゾアミン系染料をドープしたシリコンポリイミドを用いたもの:Wayne M. Gipbons他, NATURE

Vol. 351 (1991) p. 49、(2) アゾ系 染料をドープしたPVA (ポリピニルアルコール) を用 いたもの: 飯村靖文他:第18回液晶討論会 - 日本化学 会第64秋期年会 - , p. 34, 平成4年9月11日発 行、社団法人日本化学会。もしくは、Jpn. J. Ap pl. Phys. Vol. 32 (1993) pp. L9 3-L96、(3) 光重合フォトポリマーを用いたも の: Martin Schadt他、Jpn. J. Ap pl. Phys. Vol. 31 (1992) pp. 21 55-2164等を利用することができる。

【① ① 4 4 】 図 6 は、光偏光記憶膜を利用して微小領域 ことに配向処理した基板を作成するための装置を示す。 なお、各版小領域の大きさは表示回素の1 回素当たり十 分多数の微小領域が含まれるように設計する。例えば、 1 画素の大きさが1 ① ① × 3 ① ① μ m 程度の場合、一回 素の面積に数~数十の微小領域が含まれるようにする。

【① ① 4 5 】同一面積の歳小領域で広い面積を埋め尽すためには、各歳小領域の形状を正六角形や長方形。正方形、平行四辺形、ひし形、三角形等の形状とするのが好ましい。

【10046】レーザ光瀬11よりのレーザ光出方はまず 光学系(たとえば、所定形状の関口とレンズを含む)1 2で絞りこまれ、偏光特性を解消された所定のビームス ポット径を与えられる。さらに、レーザビームを所定方 向の偏光軸を有する偏光板13を通過させて直線偏光レ ーザ光14とする。直線偏光レーザ光14は光偏光記憶 膜を塗布した透明ガラス基板15の表面に、所定の微小 40 領域に対応する面積のビームスポットとなって照射され る。

【①①47】 偏光レーザビーム14の照射によって光偏 光記憶膜中の各照射機小領域は偏光板13の偏光方向に 対応した方向に配向処理がされる。ガラス基板15は2 次元方向X、Yに移動可能な可動ステージ16の上に配 置されている。可動ステージ16を移動させ、同時に偏 光板13を光軸回りに回転させて偏光方向を変えながら 偏光レーザビーム14を基板15上の光偏光記憶膜全域 にパルス状に照射する。このようにしてたとえば図7に 50

示すような多数の機小領域17をもつ配向構造が得られる。 図中の矢印は配向方向を示す。

【① 0.4.8】あるいは、レーザ光の径を拡大する光学系 および偏光板フォトマスクを備えた装置を用い、1回の レーザ照射で複数領域に一度に配向を記憶させることも 可能である。より容易に、微小領域ごとに異なる配向処 理した基板を作成することができる。

【①①49】以上の方法により光偏光記憶膜を用いて微小領域に積極的配向処理を施した液晶表示素子において 10 も、液晶層へのアクリレート樹脂材料の添加により、欠 陥発生置を抑え、さらに繁外線照射時のセル電圧を変化 させることにより欠陥発生量を制御することが可能となる。

【①①50】以上、実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。たとえば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。

[0051]

【発明の効果】光章合性アクリレート樹脂を液晶に少量 20 添加することによって、ラビングフリーの液晶表示素子 において、プレチルト角がないことによるリバースチル ト発生に起因する種々の表示欠陥を低下させて表示品質 を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例による液晶表示素子の製造工程 を示す図である。

【図2】 本発明の実施例による液晶表示素子の断面図である。

【図3】本発明の実施例による製造方法により作成した 液晶表示案子において、印加電圧を変えて撮影した表示 面の、「基板上に形成された微細なバターンを表わす」 拡大写真である。

【図4】 本発明の実施例による製造方法により、繁外線 照射時の電圧条件を変えて作成した液晶表示素子の表示 面の、「基板上に形成された微細なパターンを表わす」 拡大写真である。

【図5】特顯平5-326990号の明細書に開示のa -TN表示素子において印加電圧を変えて撮影した表示 面の、「基板上に形成された微細なパターンを表わす」 拡大写真である。

【図6】本発明の実施例による液晶表示素子の基板の配向処理を行う為の装置の斜視図である。

【図?】本発明の実施例による液晶表示素子の基板の配 向処理状態を示す拡大図である。

【符号の説明】

- 1.2 遠明ガラス基板
- 3 樹脂添加液晶材料
- 4. 容器
- 5 液晶セル
-) 6 光源

14:直線偏光レーザ光 15:選明ガラス季収 18:可動ステージ

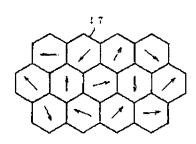
(C)

6:光原

[図?]

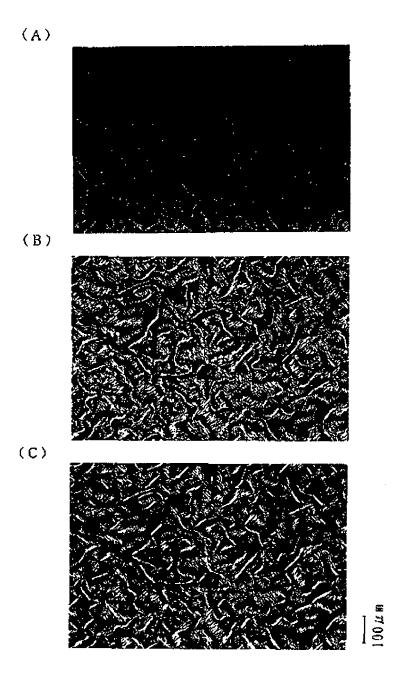
相返

実施例

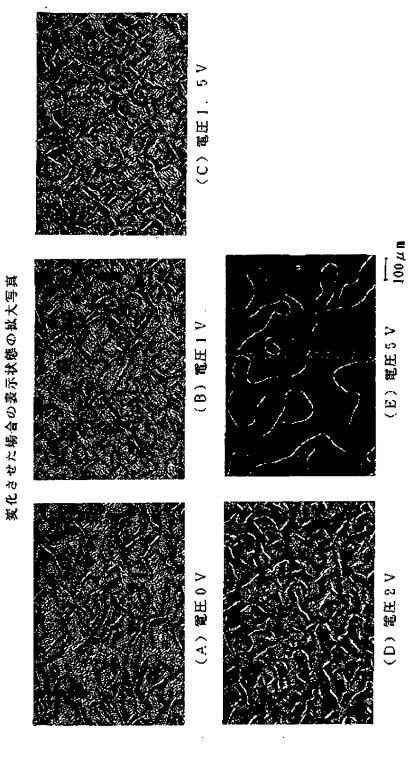


17:黄小领域

【図3】 a-TN型液晶表示素子の表示状態拡大写真

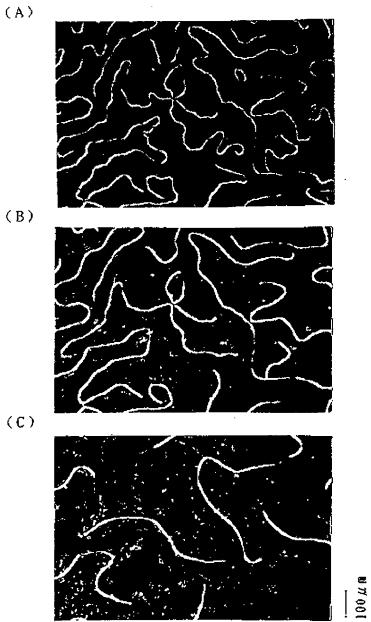


[24]



液晶表示素子における紫外線照射時の印加電圧を

[295] 先願のa-TN型液晶表示素子の表示状態拡大写真



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

_	20100tb iii uio iiiugos motuut out uzo zot zamanou to taat zotaan zamanou ii				
	☐ BLACK BORDERS				
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
	☐ FADED TEXT OR DRAWING				
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.